

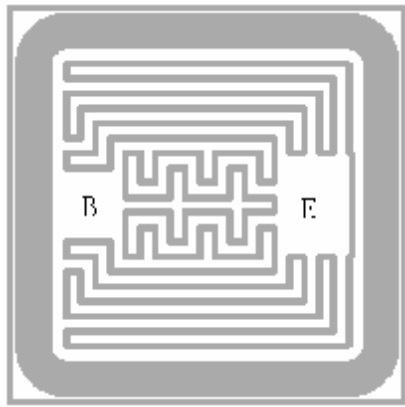
5027

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

■用 途

主要用于高压快速开关电路。

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	2800×2800μm ²
压焊区尺寸	基 区 488μm×468μm 发射区 500μm×676μm
芯片厚度	240±10μm
锯片槽宽度	70μm
金属层	正面: Al 4.0±0.4μm 背面: Ag 1.4±0.2μm

■电特性(T_a=25℃)

项 目	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	典型值	单 位
集电极-基极反向电流	I _{CBO}	V _{CB} =BV _{CBO} -20V		1.0		μA
发射极-基极反向电流	I _{EBO}	V _{EB} =7V		2		μA
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C =1mA	800		1150	V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =5mA	500		650	V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =1mA	9			V
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =200mA	10	40		
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =1A, I _B =0.2A		1.3		V